




	<h2 style="color: red;">FQD7N10LTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD7N10LTM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD7N10LTM.pdf 2.FQD7N10LTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 24892 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD7N10LTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24892 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 25W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 2.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	290pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD7N10LTM ist neu im Original, Suche FQD7N10LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD7N10LTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD7N10LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD7N10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>	 <p>FQD7N10LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>	 <p>FQD7N20 F FQD7N20 F</p>	 <p>FQD7N20L F FQD7N20L F</p>
 <p>FQD7N10 FAIRCHILD FQD7N10 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD7N10L Fairchild FQD7N10L Fairchild</p>	 <p>FQD7N10TF VB FQD7N10TF VB</p>	 <p>FQD7N10LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD630TF	↔ FQD630TM	⇒ FQD630TM	D FQD6N25TF	⇒ FQD6N25TF
⊣ FQD6N25TM	⊗ FQD6N25TM	D FQD6N40C	⇒ FQD6N40CTM	⇒ FQD6N40CTM
⊗ FQD6N50CTF	⊣ FQD6N50CTF	⊗ FQD6N50CTM	↔ FQD6N50CTM	⇒ FQD6N60C
D FQD6N60CS	⊗ FQD6N60CTF	⊣ FQD6N60CTM	⊗ FQD6N60CTM	⇒ FQD6P25TM
⇒ FQD6P25TM	↔ FQD7N10L	⊗ FQD7N10LTF	⊣ FQD7N10LTF	⇒ FQD7N10LTM
↔ FQD7N10TF	⇒ FQD7N10TM	D FQD7N10TM	⊗ FQD7N20L	⊣ FQD7N20LTF
⊗ FQD7N20LTF	D FQD7N20LTM	⇒ FQD7N20LTM	↔ FQD7N20TF	⇒ FQD7N20TF
⊣ FQD7N20TM	⊗ FQD7N20TM	↔ FQD7N30TM	⇒ FQD7N30TM	⇒ FQD7P06TF
⊗ FQD7P06TF	⊣ FQD7P06TM	⊗ FQD7P06TM	D FQD7P06TM_F080	⇒ FQD7P06TM_F080
↔ FQD7P06TM_NB82050	⊗ FQD7P06TM_NB82050	⊣ FQD7P10TF	⊗ FQD7P20TF	⇒ FQD7P20TF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited